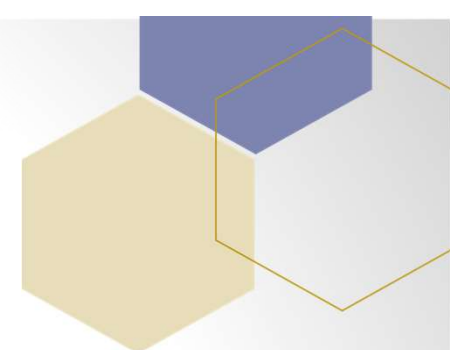
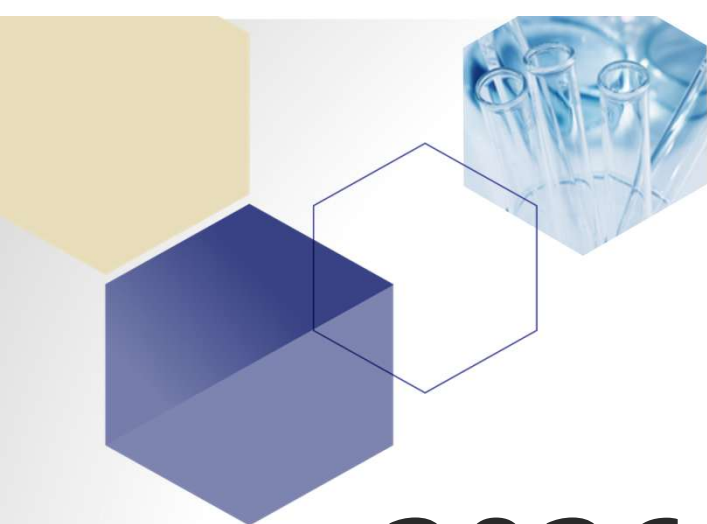




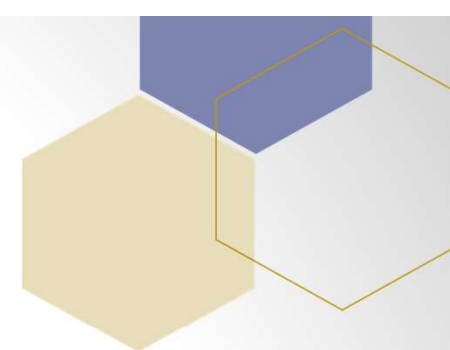
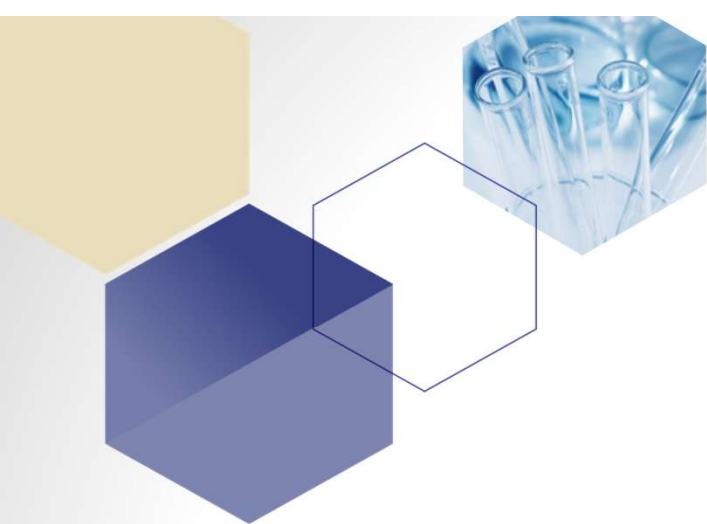
2026年3月期 第2四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

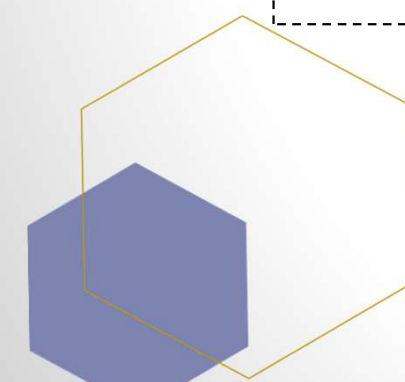
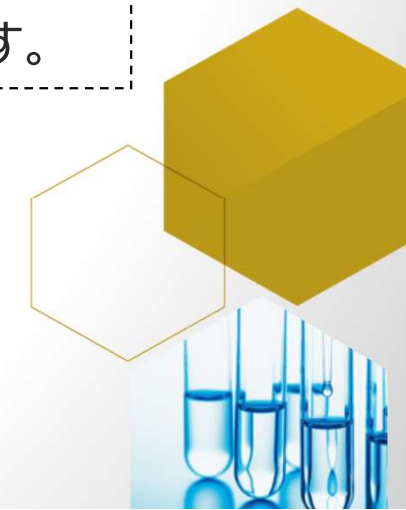
証券コード：4973

2025年10月24日



決算の概況

(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
 - 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

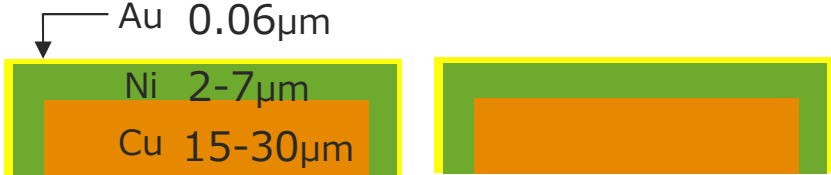
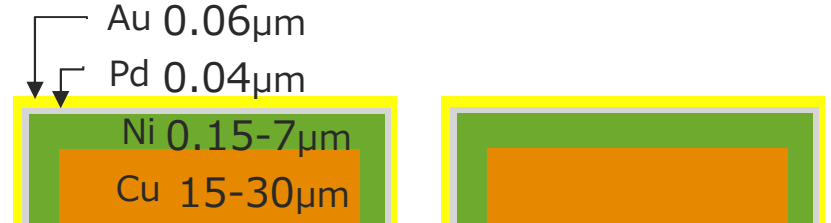
めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクター	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバー・PC・スマートフォン等の半導体搭載基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体搭載基板 サーバー・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバー・PC等の半導体搭載基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

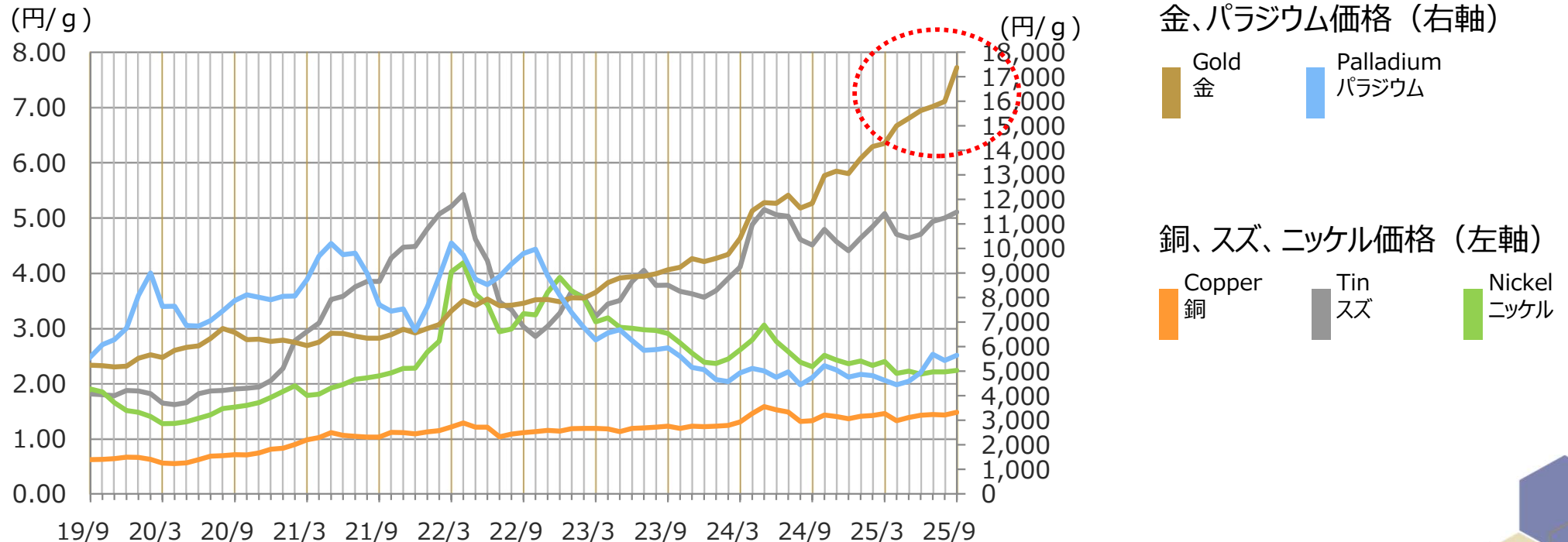
用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Cu 15-30μm
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	 Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm

2026年3月期 第2四半期外部環境

電子部品業界の状況

- 生成AI向けの旺盛な需要に牽引され、AIサーバやデータセンター向けは引き続き好調に推移したが、米中貿易摩擦などの影響を受け、スマートフォンやパソコンなどの民生向けやFA機器などの産業機器向けは緩やかな需要回復に留まる
- 車載用電子部品においては、先進運転支援システムなどの電装化に伴う需要増はあったものの、米国の関税措置や電気自動車の成長鈍化の影響を受けて需要は伸び悩む

貴金属の概況



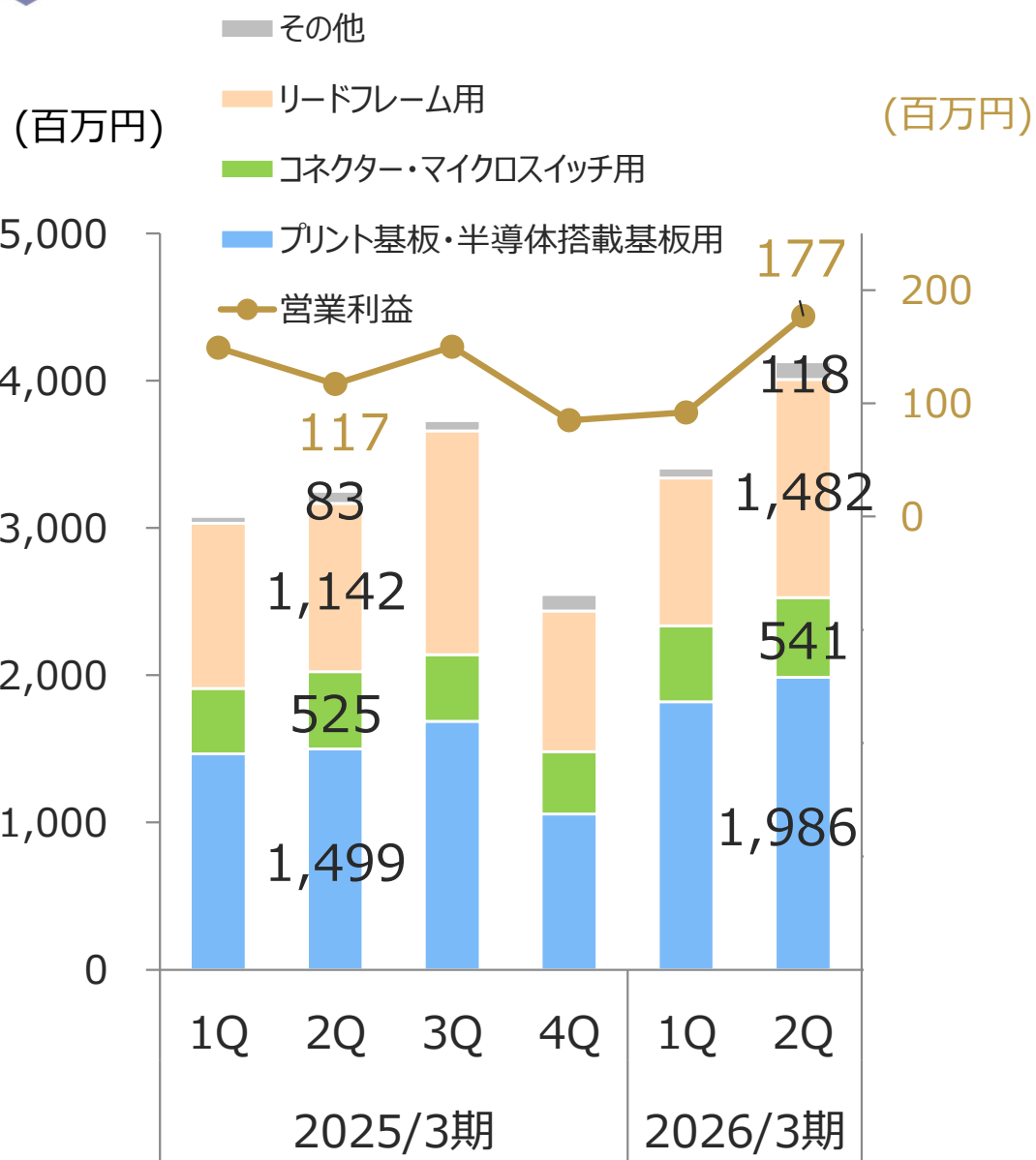
2026年3月期 第2四半期決算概況（累計）

当社の決算概況：増収減益

- 売上高：スマートフォンやパソコンなど民生向け需要は緩やかな回復基調で推移したことに加えて、生成AI関連需要の拡大により、半導体パッケージ、モジュール、およびメモリー向けの販売が堅調に推移。また貴金属価格の上昇も加わり、前年比+19.0%の増収
- 営業利益：粗利は増加したものの、人的資本への積極的な投資により費用が増加
その結果、営業利益は前年同期比+1.9%の増益にとどまる
- 四半期純利益：営業利益は前年同期比微増であったが、政策保有株式の売却タイミングの相違により前年同期比△24.0%の減益

(単位：百万円)	2025/3期 2Q累計	2026/3期					
		1 Q	2Q	2Q累計		増減率	2 Q進捗率 (期初予想比)
売 上 高	6,330	3,406	4,129	7,536	+19.0%	53.8%	
営 業 利 益	266	92	178	271	+1.9%	53.2%	
経 常 利 益	359	184	193	378	+5.0%	56.4%	
四 半 期 純 利 益	822	135	489	624	△24.0%	124.8%	
1株当たり 四 半 期 純 利 益	142.56円	23.40円	84.60円	108.04円	－	－	

売上高・営業利益の推移

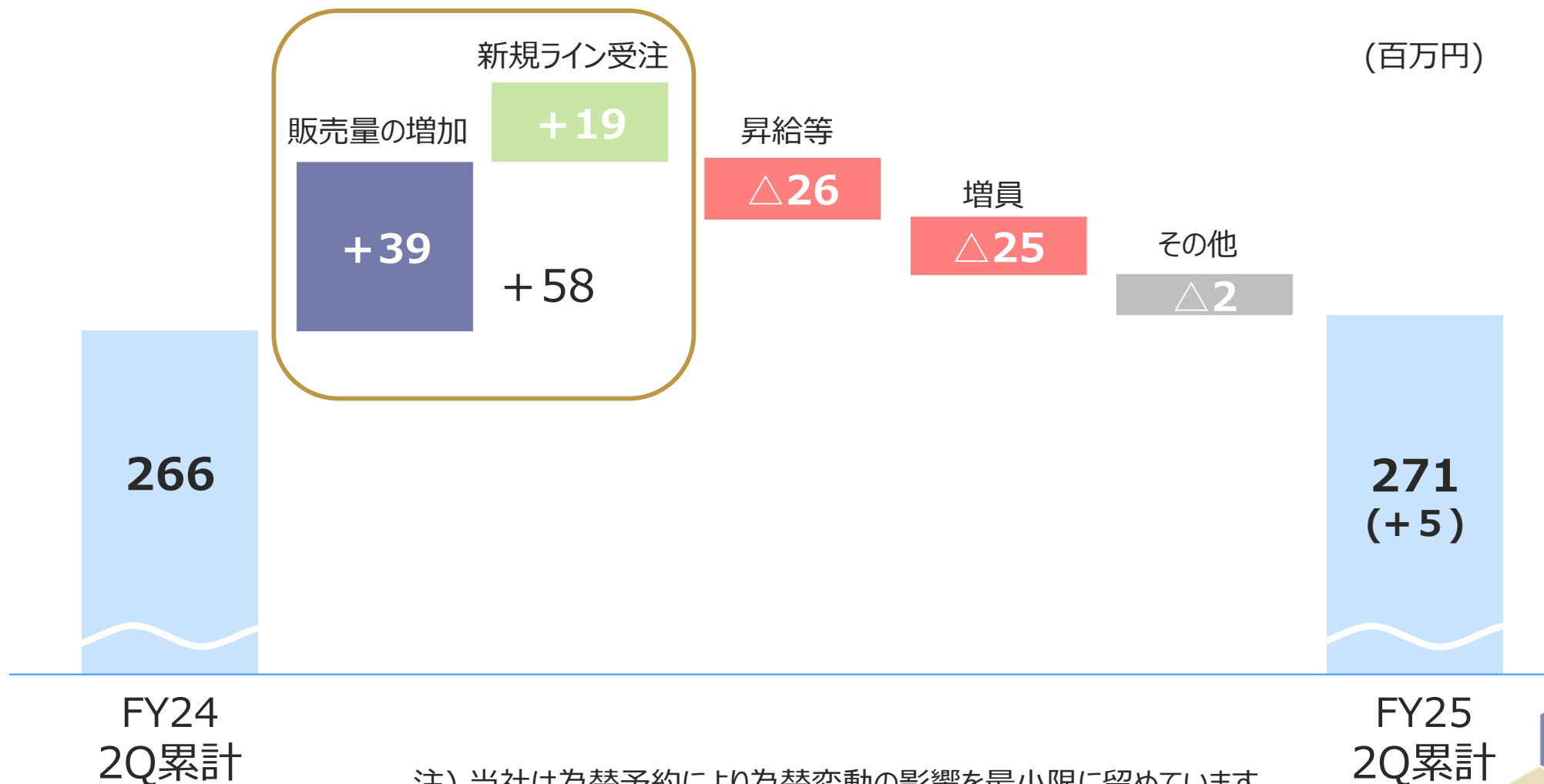


カテゴリー別概況（前年同四半期比）

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
スマートフォンやパソコンなどの民生向けは緩やかな回復となったのに加え、生成AI関連の半導体パッケージ、光通信モジュール及びメモリ向けは堅調に推移し増収
- コネクター用めっき薬品
車載向けで足踏み感が見られたが、スマートフォン向けや産業機器向けで底堅く推移し微増
- リードフレーム用めっき薬品
車載向けで足踏み感が見られたが、民生向けで堅調に推移したうえ、貴金属価格の上昇も加わり増収

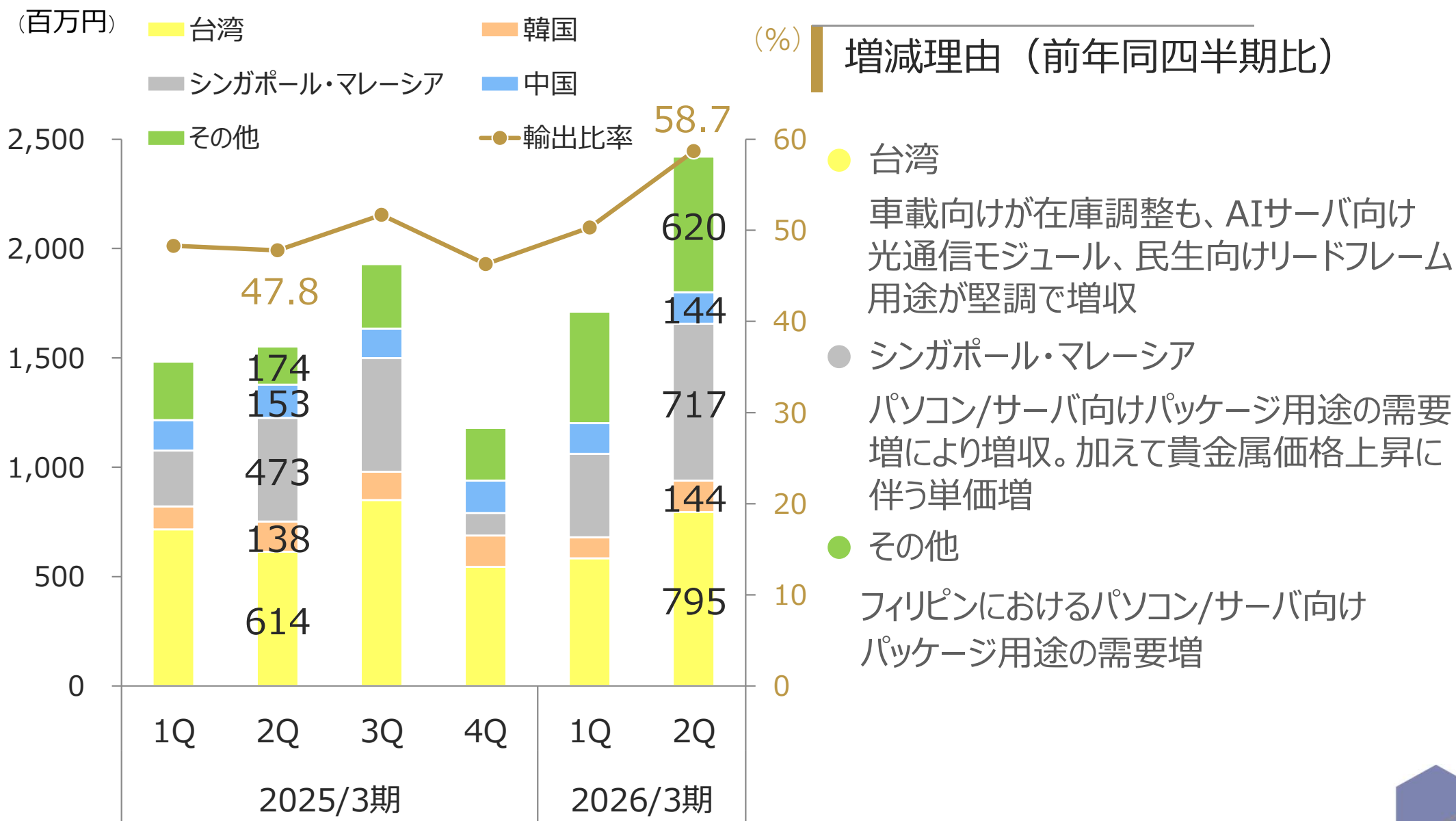
営業損益増減要因（前年同期比）

- スマートフォンやパソコンなどの民生向けの穏やかな回復に加え、新規ライン受注で前年比58百万円の増益
- 人的資本への先行投資を積極的に進め、将来の事業成長を加速させる



注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています。

輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



2026年3月期 見通し

- サーバ／データセンター向けは、生成AI向けの旺盛な需要増に引き続き支えられ、好調な推移を想定
- スマートフォンやPC等の民生向けは、緩やかながらも需要回復を見込むが、米国の関税政策の影響により販売計画に遅れの懸念あり
- 車載向けは電気自動車の需要鈍化による在庫調整長期化の懸念
- 投資有価証券売却益を特別利益に見込み、当期純利益の通期見通しは1,450百万円

(単位：百万円)	2025/3期	2026/3期	前期比
売上高	12,611	14,000	+11.0%
営業利益	502	510	+1.5%
経常利益	657	670	+1.9%
投資有価証券売却益	1,512	1,350	—
当期純利益	1,579	1,450	△8.2%
配当	126円	126円	+0円
ROE	11.3%	9.4%	—

政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、中期経営計画 FY2025-2027の期間中に純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています。
- 上記方針に沿って、今年度においても売却を進めております。売却の経過と今後の見通しにつきましては、2025年10月24日公表の「(開示事項の経過)投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ」をご覧ください。

	2024年 9月末	2024年 12月末	2025年 3月末	2025年 6月末	2025年 9月末
売却額 ※ (百万円)	752	553	275	—	493
保有株式時価 (百万円)	7,236	7,108	5,974	6,740	8,416
純資産額 (百万円)	14,052	14,149	13,594	13,891	15,566
純資産に対する割合 (%)	51.5	50.2	43.9	48.5	54.1

※ 該当四半期中での売却額

トピックス：光トランシーバー(光モジュール)分野での展開

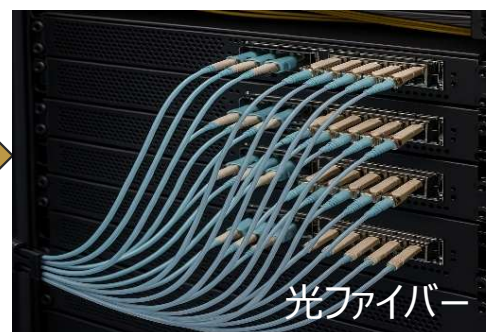
データセンター外観



データセンター内

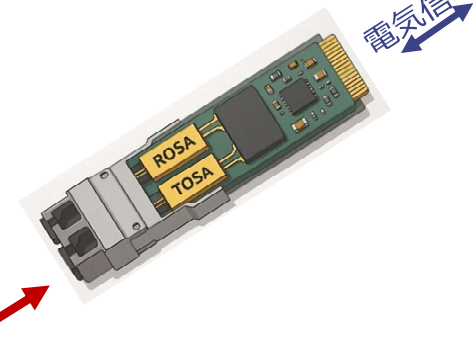


サーバーラック拡大



光ファイバー

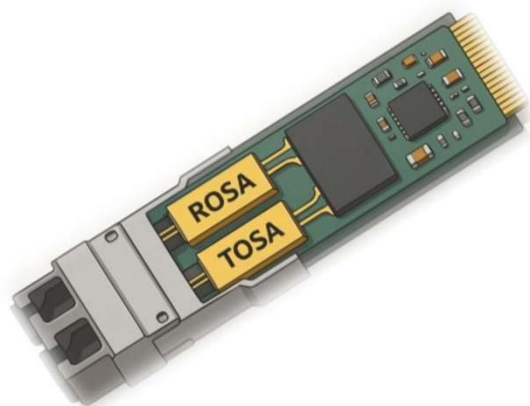
光トランシーバー



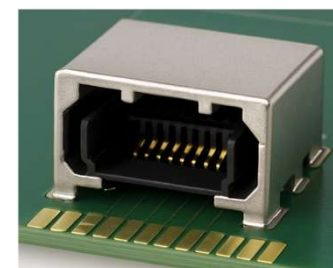
光トランシーバ
の接点

電気信号

光信号

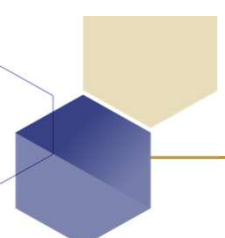


※基板側のコネクター



※画像イメージです

光トランシーバ(光モジュール)とは電気信号を光信号に変換するためのモジュールで
電気的接点・基板・光電変換モジュールから構成される



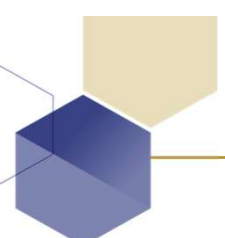
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7 月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3 月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3 月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2 月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4 月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4 月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライト企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2025年9月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>